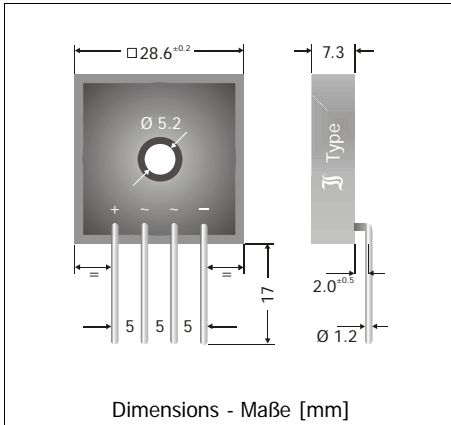


**KBPC3500I ... KBPC3510I**
**Silicon-Bridge-Rectifiers  
Silizium-Brückengleichrichter**

Version 2006-08-11



Nominal current Nennstrom	35 A
Alternating input voltage Eingangswchelspannung	35...700 V
Plastik case – Plastikgehäuse	28.6 x 28.6 x 7.3 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	17 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067  
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswchelspannung $V_{VRMS}$ [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>1)</sup>
KBPC3500I	35	50
KBPC3501I	70	100
KBPC3502I	140	200
KBPC3504I	280	400
KBPC3506I	420	600
KBPC3508I	560	800
KBPC3510I	700	1000

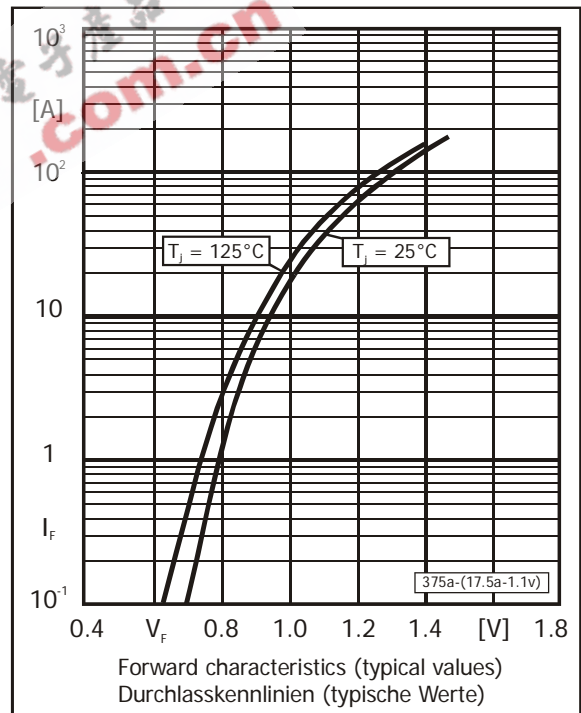
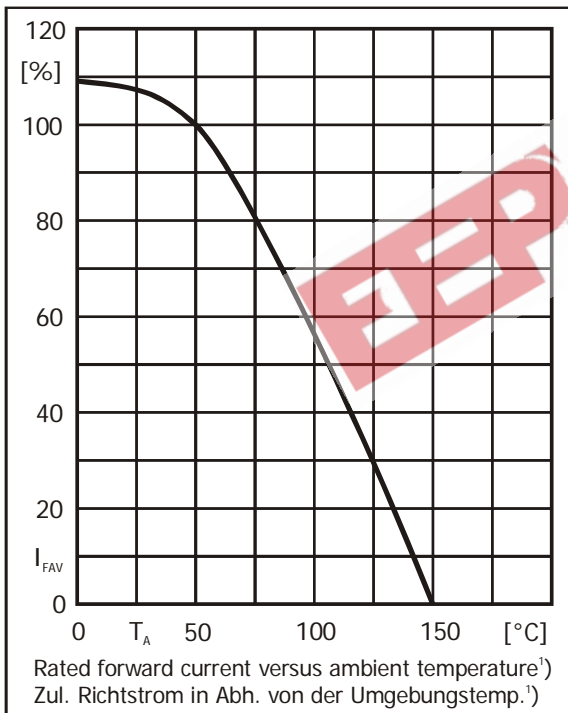
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	$I_{FRM}$	80 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	375 A
Peak forward surge current 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	400 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	660 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_J$	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	-50...+150°C

1 Valid per diode – Gültig pro Diode

2 Valid, if the temperature of the case is kept to  $T_C = 120^\circ\text{C}$  – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf  $T_C = 120^\circ\text{C}$  gehalten wird

**Characteristics**
**Kenwerte**

Max. current with cooling fin 300 cm <sup>2</sup> <sup>1</sup> Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm <sup>2</sup>	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load C-load	$I_{FAV}$ $I_{FAV}$	35 A 28 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 17.5\text{ A}$	$V_F$	< 1.1 V <sup>2)</sup>
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 25 $\mu\text{A}$
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			$V_{ISO}$	> 2500 V
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			$R_{thc}$	< 1.5 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		10-32 UNF M5		18 $\pm$ 10% lb.in. 2 $\pm$ 10% Nm



1 Valid, if the temperature of the case is kept to  $T_C = 120^\circ\text{C}$  – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf  $T_C = 120^\circ\text{C}$  gehalten wird  
 2 Valid per diode – Gültig pro Diode